

No	発表日	講演No	発表時間	会場	セクション	講演タイトル	講演者	区分
1		18a-223-4	10:00-10:15	223	6.3 酸化物エレクトロニクス	スピン流熱電変換素子の磁性層としての $\text{La}_2\text{NiMnO}_6$	○寺林 真輝 ¹ 、関 真一郎 ² 、中村 優男 ² 、川崎 雅司 ^{2,3} 、石橋 幸治 ² 、齋藤 智彦 ¹ 、松野 丈夫 ^{2,4,5} (1.東理大理、2.理研CEMS、3.東大工、4.阪大理、5.JSTさきがけ)	Oral
2	9/18	18p-224B-8	15:00-15:15	224B	17.3 層状物質	分子線エピタキシー法による NbSe_2 超薄膜の作製と二次元超伝導物性	○松岡 秀樹 ¹ 、中野 匡規 ¹ 、小濱 芳允 ^{1,3} 、王 越 ¹ 、柏原 悠太 ¹ 、吉田 訓 ¹ 、松井 一樹 ³ 、下起 敬史 ¹ 、大内 拓 ⁴ 、石坂 香子 ^{1,2} 、野島 勉 ⁴ 、川崎 雅司 ^{1,2} 、岩佐 義宏 ^{1,2} (1.東大院工、2.理研CEMS、3.東大物性研、4.東北大金研)	
3	9/19	19p-133-16	18:00-18:15	133	6.1 強誘電体薄膜	電極の最適化による移動度の影響を受けないシフト電流の実証	○畑田 大輝 ¹ 、中村 優男 ^{2,3} 、金子 良夫 ² 、小川 直毅 ^{2,3} 、十倉 好紀 ^{1,2} 、川崎 雅司 ^{1,2} (1.東大院工、2.理研CEMS、3.JST さきがけ)	
4		19p-234B-11	16:00-16:15	234B	6.4 薄膜新材料	分子線エピタキシー法による新規磁性半導体 EuAs 薄膜の作製	○佐藤 慎 ¹ 、打田 正輝 ¹ 、中澤 佑介 ¹ 、西早 辰一 ¹ 、川崎 雅司 ^{1,2} (1.東大工、2.理研CEMS)	